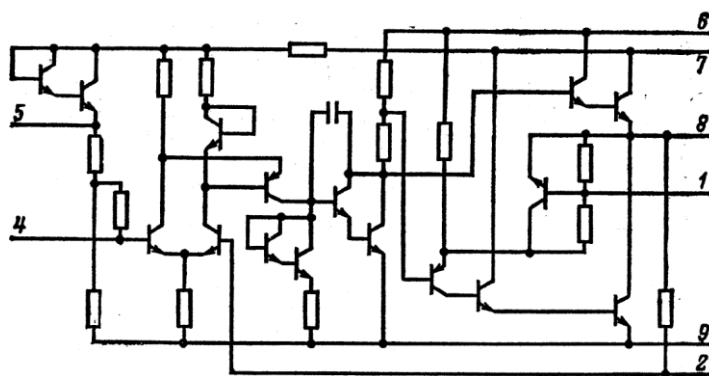


К1УС744А, К1УС744Б

Микросхемы представляют собой усилитель мощности звуковой частоты. Содержат 32 интегральных элемента. Корпус типа 201.9-1, масса не более 1,2 г.



Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	9 В +10/-40%
Ток потребления	не более 10 мА
Коэффициент усиления по напряжению	4...10
Нестабильность коэффициента усиления по напряжению	не более 20%
Входное сопротивление	не менее 10 кОм
Диапазон рабочих частот	30...20000 Гц
Выходная мощность при сопротивлении нагрузки 4 Ом	
К1УС744А	1 Вт
К1УС744Б	0,7 Вт
Коэффициент гармоник	не более 2,0%
Коэффициент полезного действия	
К1УС744А	50%
К1УС744Б	35%
Тепловое сопротивление кристалл-корпус	60°C/Вт
Тепловое сопротивление кристалл-среда	135°C/Вт

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	8,1...9,9 В
Максимальное выходное напряжение	
К1УС744А	2 В
К1УС744Б	1,7 В
Максимальная амплитуда тока нагрузки	
К1УС744А	860 мА
К1УС744Б	710 мА
Температура кристалла	+125°C
Температура окружающей среды	-30...+ 55° С
Относительная влажность воздуха, при температуре 40°C	98%
Вибрация в диапазоне частот 1-600 Гц	10 g
Многokратные удары с ускорением	75 g
Однократные удары с ускорением	25 g

Общие рекомендации по применению

При проведении монтажных операций допускается не более двух перепаек выводов микросхем.

Температура пайки $235 \pm 5^\circ\text{C}$, расстояние от корпуса до места пайки не менее 1,5 мм, продолжительность пайки не более 6 с.

При эксплуатации микросхемы должна быть предусмотрена защита от случайного увеличения напряжения питания.

Эксплуатация микросхем допускается только с применением теплоотвода.

Для устранения высокочастотной генерации необходимо уменьшать индуктивность проводов, соединяющих вывод 7 с источником питания, использовать только короткие провода, экранировать провод, соединяющий вход микросхемы с генератором сигналов.

Регулировка коэффициента усиления напряжения на низких частотах может быть проведена изменением емкостей конденсаторов обратной связи. Ослабление усиления на верхней граничной частоте 20 кГц — не более 3 дБ. Допускается регулировка коэффициента усиления напряжения с помощью изменения сопротивления резистора обратной связи и емкости конденсатора обратной связи.

Допустимое значение статического потенциала 200 В.